

中国南科集团应用于开关电源高反压(600V)功率 POWER MOSFET 系列

新产品介绍

6-16-06

广泛应用于开关电源，能耐 600V 以上冲击电压的功率 POWER MOSFET 系列产品过去全都是由国外进口，或是由外国提供芯片而在国内封装。

中国南科集团有我国华南地区唯一的 6 英寸芯片生产线，同时集团本身更拥有由芯片设计、芯片制造及芯片测试与封装等完整的产业链，加上本集团创办人旅美台胞吴纬国博士是台湾新竹科学园区及 IC 产业界的先驱，具有逾 25 年 POWER MOSFET 的研发及生产经验，在其亲自带领下，经本集团近三年的不懈努力，近已成功开发并推出一系列由 0.3A(11.5 欧姆)至 7.0A(0.95 欧姆)能耐 600 伏高压的功率 POWER MOSFET 三极管，其产品性能与美国 FAIRCHILD 及欧洲意法半导体同类型产品性能相同，按照功率的不同要求及是否需用贴片式组装可封装在 TO-251/252 及 TO-220/263 等四种封装型式内。

此系列产品的规格详见如下表：

型号	耐压 (V)	漏电 (600V)	栅极漏电 ($<0.1 \mu A$)	内阻 (欧姆)	开启电压 (V)	V_{SD} (V)	可替代产品	
							FAIRCHILD	意法半导体
NK1N60	600	100 μA	$\pm 30V$	11.5	2~5	2	FQN1N60C	STN1NK60Z
NK2N60	600	100 μA	$\pm 30V$	4.7	2~5	2.7	FQP2N60	STP3NK60Z
NK3N60	600	100 μA	$\pm 30V$	3.6	2~5	2.7	FQP3N60	STP3NK60Z
NK4N60	600	100 μA	$\pm 30V$	2.2	2~5	2.7	FQP4N60	STP4NK60Z
NK5N60	600	100 μA	$\pm 30V$	2.5	2~5	2.7	FQPF5N60C	STP4NK60Z
NK6N60	600	100 μA	$\pm 30V$	2	2~5	2.7	FQP6N60C	STP5NK60Z
NK7N60	600	100 μA	$\pm 30V$	1	2~5	2.7	FQP7N60	STP8NM60
NK8N60	600	100 μA	$\pm 30V$	1.2	2~5	2.7	FQP8N60C	STP8NM60
NK9N60	600	100 μA	$\pm 30V$	0.95	2~5	2.7	——	STP9NK60Z

中国南科集团能耐 600V 高压冲击 POWER MOSFET 系列产品的推出，标志着我国在高压 POWER MOSFET 的技术领域内已掌握核心技术，并可完全取代进口同类型产品，填补了我国同类产品之空白，更将对我国开关电源产品内的关键零件的国产化起到一定的贡献。